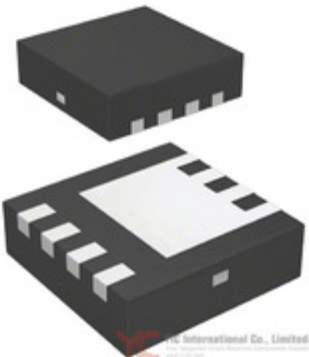



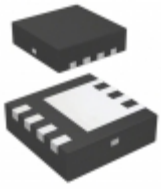
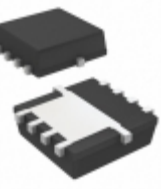
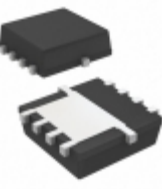

	<h2 style="color: #D9534F;">SISS27DN-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SISS27DN-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 50A PPAK 1212-8S
	Datenblätter:  SISS27DN-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 9000 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SISS27DN-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 50A PPAK 1212-8S
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	9000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8S (3.3x3.3)
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.6 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	4.8W (Ta), 57W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	-50°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5250pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	140nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

SISS27DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SISS27DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SISS27DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SISS27DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SISS27DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 50A PPAK 1212-8S</p>	 <p>SISS23DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 50A PPAK 1212-8S</p>	 <p>SISS27ADN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 50A 1212-8</p>	 <p>SISS28DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 25V 60A 1212-8</p>
 <p>SISS40DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 36.5A PPAK 1212</p>	 <p>SISS26DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHANNEL 60V 60A 1212-8S</p>	 <p>SISS27ADN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 50A POWERPAK1212</p>	 <p>SISS40DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 36.5A PPAK 1212</p>

SISS27DN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SISS27DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SISS27DN-T1-GE3 Datenblatt	SISS27DN-T1-GE3-Datenblätter	SISS27DN-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SISS27DN-T1-GE3
SISS27DN-T1-GE3 Electronic	SISS27DN-T1-GE3-Komponenten	SISS27DN-T1-GE3-Verteiler	SISS27DN-T1-GE3-Bild	SISS27DN-T1-GE3-Teil
SISS27DN-T1-GE3 Preis	SISS27DN-T1-GE3 Hersteller	SISS27DN-T1-GE3 Bild	SISS27DN-T1-GE3 Aktie	SISS27DN-T1-GE3 Inventar
SISS27DN-T1-GE3 Neu	SISS27DN-T1-GE3 Original	SISS27DN-T1-GE3 garantiert	SISS27DN-T1-GE3 RFQ	SISS27DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited